Silicon Diode

BAY60

25V / 100mA

DATASHEET

OEM - Valvo

Source: Valvo Halbleiterdioden und Transistoren 1967

BAY 60

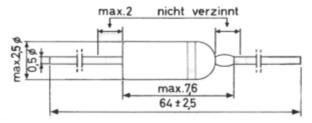
SILIZIUM-PLANAR-DIODE

für schnelle Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Gehäuse: Allglas, DO-7 Farbring: Katodenseite

Maßangaben in mm.



<u>Kurzdaten</u> :					
Sperrspannung	$\mathbf{U}_{\mathbf{R}}$	=	max.	25	v
Durchlaßstrom	I_F	=	max.	100	mA
Verlustleistung	P	=	max.	250	mW
Umgebungstemperatur	$\vartheta_{\mathbf{U}}$	=	max.	125	$^{\mathrm{o}}\mathrm{c}$
Durchlaßspannung bei $I_F = 30$ mA, $\theta_U = 25$ °C	$\mathbf{v}_{\mathbf{F}}$	≦		1,0	v
Sperrstrom bei $U_R = 25$ V, $\vartheta_U = 25$ °C	I_R	≦		100	nA
Kleinsignalkapazität bei U _R ≈ 0	С	≤		4	pF
Sperrverzögerungszeit beim Umschalten von I $_{ m F}$ = 10 mA auf U $_{ m R}$ = 6 V	$^{\mathrm{t}}\mathbf{rr}$	=		2	ns

BAY 60

```
Absolute Grenzwerte: (bei 9U = 25 °C)
                                                                        U_R = max. 25 V
Sperrspannung:
                                                                        I_F = max. 100 mA
Durchlaßstrom:
                                                                             = max. 250 mW
Verlustleistung:
                                                                         θ<sub>U</sub> = min. -55 °C
Umgebungstemperatur:
                                                                        \vartheta_{\mathrm{U}} = \mathrm{max.} 125 \, \mathrm{^{o}C}
Wärmewiderstand:
                                                                       R_{th~U} \stackrel{\leq}{=} 0,4~grd/mW
Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung:
<u>Kennwerte</u>: (bei \vartheta_{\text{U}} = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
                                                                        U<sub>F</sub> ≤
Durchlaßspannung bei ...IF .= 30 mA:
                                                                                    1,0 V
                                                                        ı<sub>R</sub> ≦
Sperrstrom bei U_R = 25 V:
                                                                                     100 nA
            bei U_R = 25 V, \theta_U = 100 °C
                                                                                      25 μA
Kleinsignalkapazität bei U_R = 0:
                                                                                       4 pF
Sperrverzögerungszeit
beim Umschalten von I_F = 10 mA auf U_R = 6 V,
```

 $R = 100 \Omega$:

Sperrverzögerungszeit

beim Umschalten von $I_F = 10$ mA auf $i_{R M} = 10$ mA, gemessen bei $i_R = 1$ mA: